## Исследование сверхпроводящих свойств системы Cu–C в миллиметровом диапазоне длин волн

© В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, О.И. Коньков\*, Е.И. Теруков\*

Санкт-Петербургский государственный технический университет, 195251 Санкт-Петербург, Россия

\*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 17 октября 1995 г.)

Исследованы свойства цилиндрического порошкообразного образца системы Cu-C как микроволновой антенны на частоте 35 GHz в интервале температур 80–300 К. Показано, что добротность такой антенны увеличивается при понижении температуры от комнатной до азотной практически в 2 раза, что связано, по-видимому, со сверхпроводящим переходом в области температур около 80 К.

В работе [1] сообщалось о наблюдении сверхпроводящего перехода в порошкообразных образцах системы Cu–C с температурой фазового перехода, лежащей в интервале 80-120 К в зависимости от состояния образца. Фазовый переход регистрировался по температурной зависимости сигнала микроволнового поглощения, магнитной восприимчивости и сопротивления на низких частотах (~ 1 kHz). Там же описана технология приготовления образцов Cu–C и приведены предварительные данные по их рентгеноструктурному сигналу, согласно которым в образцах, полученных на основе фуллерена (в качестве исходного материала), содержатся по крайней мере три фазы. Основу двух из них составляют аморфный углерод и кластеры меди, а третья фаза пока не расшифрована.

В ряде работ [2–5] докладывалось о существенном увеличении добротности микроволновых антенн на частотах 220 MHz–36 GHz с активным элементом, изготовленным из высокотемпературных керамических сверхпроводников. В настоящей работе приводятся результаты аналогичных исследований на частоте 35 GHz с использованием в качестве антенны порошкообразного образца Си–С. Исследовалась температурная зависимость излучаемой СВЧ-мощности и измерялась ширина амплитудно-частотной характеристики антенны при T = 300 и 77 K.

Схема установки приведена на рис. 1. Порошок Си–С засыпался в полиэтиленовую трубку с внутренним диаметром 2 mm, длиной 8 mm и толщиной стенки 0.5 mm. С торцов образец поджимался стеклоуглеродными блоками для обеспечения надежного контакта между частицами порошка и помещался на щель (50  $\mu$ m × 8 mm) в широкой стенке волновода. Для получения оптимальных условий возбуждения образец мог перемещаться поперек щели, дополнительная подстройка осуществлялась короткозамкнутым поршнем на одном из концов волновода. Для регистрации излучения на расстоянии порядка 10  $\lambda$  от образца устанавливалась рупорная приемная антенна, сигнал от которой поступал на вход анализатора спектра. При измерении амплитудно-частотной харак-

теристики антенны происходит сканирование частоты генератора СВЧ-мощности в диапазоне  $\Delta \nu \sim 1$  GHz.

На рис. 2 представлена температурная зависимость мощности излучения (кривая 1), на которой отчетливо видно резкое увеличение мощности излучения P при T < 80 K, соответствующее столь же резкому уменьшению сопротивления образца (кривая 2) (немонотонность зависимости P(T) в области температур 105–110 K является аппаратурной). Из этого рисунка видно, что существует определенная корреляция между зависимостями P(T) и R(T), а температуру 80 K можно считать температурой  $T_c$  начала фазового сверхпроводящего перехода. Очевидно, что если при этом действительно происходит переход образца в сверхпроводящее состояние, то при  $T < T_c$  должна также заметно возрасти добротность антенны, т.е. уменьшиться ширина амплитудно-частотной характеристики (АЧХ).



Рис. 1. Схема установки для исследования амплитудночастотных характеристик микроволновой антенны на основе Си–С. 1 — волновод, 2 — короткозамкнутый поршень, 3 — щель, 4 — образец, 5 — механизм перемещения образца, 6 — приемная рупорная антенна, 7 — напряжение частотой 1–100 kHz от генератора ГЗ-112, 8,9 — нановольтметры 232.B.Unipan, 10 — СВЧ-генератор Р2-65, 11 — амплитудночастотный анализатор Г4-161.



**Рис. 2.** Температурная зависимость мощности, излучаемой Си–С-антенной (1), и сопротивления образца Си–С (2). Мощность выражена в dB к уровню 1 mW.



**Рис. 3.** Амплитудно-частотная характеристика антенны Cu–C при комнатной (*1н*) и азотной (*2*) температурах.

На рис. 3 приведены амплитудно-частотные характеристики исследуемой антенны с активным элементом Cu-C при температурах 300 и 77 К. Как видно из этого рисунка, действительно ширина AЧX при T = 77 К на уровне 0.7, составляющая  $\Delta \nu_{77} = 47$  MHz (0.3%), почти в 2 раза меньше, чем при T = 300 К ( $\Delta \nu_{300} = 86$  MHz). Необходимо отметить, что полученные значения  $\Delta \nu$  почти в 10 раз меньше значений, приведенных в [5] для пленочной антенны из Bi<sub>2</sub>Gr<sub>2</sub>CaCuO<sub>8</sub> при азотной температуре на частоте 35 GHz ( $\Delta \nu_{77} = 400$  MHz). С нашей точки зрения, столь значительное увеличение добротности антенны в данном случае обусловлено тем, что она нагружена не на свободное пространство непо-

средственно, а через диэлектрический резонатор, которым является полиэтиленовая трубка. Свойства таких трубок как диэлектрических резонаторов исследовались нами ранее [6].

Таким образом, приведенные в настоящей работе результаты исследования системы Си–С на сверхвысоких частотах, как нам представляется, служат дополнительным подтверждением существования в этой системе сверхпроводящего фазового перехода при азотной температуре.

Работа частично поддерживалась в рамках Межотраслевой научно-технической программы России "Фуллерены и атомные кластеры" и US Department of Defence.

## Список литературы

- В.Ф. Мастеров, О.И. Коньков, А.В. Приходько, Е.И. Теруков, С.Г. Ястребов. Письма в ЖТФ 20, 15, 17 (1994).
- [2] S.K. Khamas, M.J. Mehler, T.S.M. Maclean, C.E. Gough, N.McN Alford, M.A. Harmer. Electr. Lett. 24, 8, 460 (1988).
- [3] H. Aisheng, S. Changsheng, Z. Jincang, L. Nan, T. Bin, L. Darong, Z. Meiling, W. Weiguo, H. Yusheng. Cryogenics 30, 9, 946 (1990).
- [4] R.J. Dinger. J. Supercond. 3, 3, 287 (1990).
- [5] V. Celik, A. Prichodko, R. Raguotis, B. Vengalis. Int. J. Infrared Mm Waves 15, 3, 303 (1994).
- [6] M.N. Kotov, V.F. Masterov, A.V. Prichodko, O.V. Smertin. Int. J. Infrared Mm Waves 14, 5, 895 (1993).